

P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DMOS FET

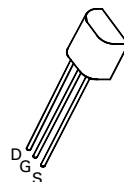
ISSUE 2 – SEPT 93

BS250P

FEATURES

- * 45 Volt V_{DS}
- * $R_{DS(on)}=14\Omega$

REFER TO ZVP2106A FOR GRAPHS



E-Line
TO92 Compatible

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Drain-Source Voltage	V_{DS}	-45	V
Continuous Drain Current at $T_{amb}=25^{\circ}C$	I_D	-230	mA
Pulsed Drain Current	I_{DM}	-3	A
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 20	V
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	700	mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	-45			V	$I_D=-100\mu A, V_{GS}=0V$
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	-1		-3.5	V	$I_D=-1mA, V_{DS}=V_{GS}$
Gate Body Leakage	I_{GSS}			-20	nA	$V_{GS}=-15V, V_{DS}=0V$
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}			-500	nA	$V_{GS}=0V, V_{DS}=-25V$
Static Drain-Source on-State Resistance (1)	$R_{DS(on)}$			14	Ω	$V_{GS}=-10V, I_D=-200mA$
Forward Transconductance (1)(2)	g_{fs}		150		mS	$V_{DS}=-10V, I_D=-200mA$
Input Capacitance (2)	C_{iss}		60		pF	$V_{GS}=0V, V_{DS}=-10V$ $f=1MHz$
Turn-On Time (2)(3)	$t_{(on)}$			20	ns	$V_{DD}=-25V, I_D=-500mA$
Turn-Off Time (2)(3)	$t_{(off)}$			20	ns	

- (1) Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$ (2) Sample test
(3) Switching times measured with a 50 Ω source impedance and <5ns rise time on a pulse generator

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9